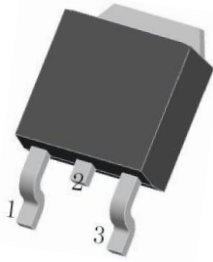


型号: 2P4M

外形: T0-252

产品名称: 单向可控硅

TO-252外形图



极性: 三个引脚从左至右 1: K 2: A 3: G

用途: 广泛用于各种万能开关器、小型马达控制器、彩灯控制器、漏电保护器、灯具继电器激励器、逻辑集成电路驱动、大功率可控硅门极驱动、摩托车点火器等线路功率控制。

极限值范围 (TA=25°C 除非另外规定)

项 目	符 号	额 定 值	单 位
断态重复峰值电压	VDRM	600	V
反向重复峰值电压	VRRM	600	V
通态平均电流	IT	2	A
通态不重复浪涌电流	ITSM	20	A
结 温	Tj	110	°C
贮 存 温 度	Tstg	-40~150	°C

电参数特性(TA=25°C 除非另外规定)

参 数	符 号	测 试 条 件	最 小 值	最 大 值	单 位
断态重复峰值电压	VDRM	IDRM=10uA	600		V
反向重复峰值电压	VRRM	IRRM=10uA	600		V
重复峰值阻断电流	IDRM/IRRM	VD/VR=VDRM/VRRM		10	uA
通态 峰 值 电 压	VTM	IT=2A		1.7	V
擎住电流	IL	Vd=24V IT=50mA		5	mA
维 持 电 流	IH	Vd=24v IT=50mA		5	mA
门极触发电流	IGT	Vd=12v RL=100Ω		150	uA
门极触发电压	VGT	Vd=12v RL=100Ω		1.2	V

典型特性曲线图

FIG.1 Maximum power dissipation versus RMS on-state current

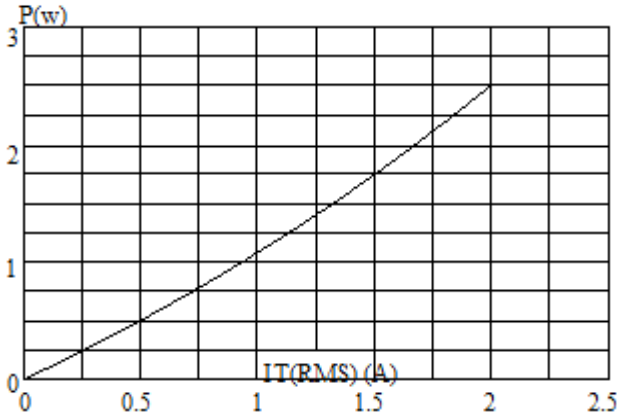


FIG.2: RMS on-state current versus case temperature

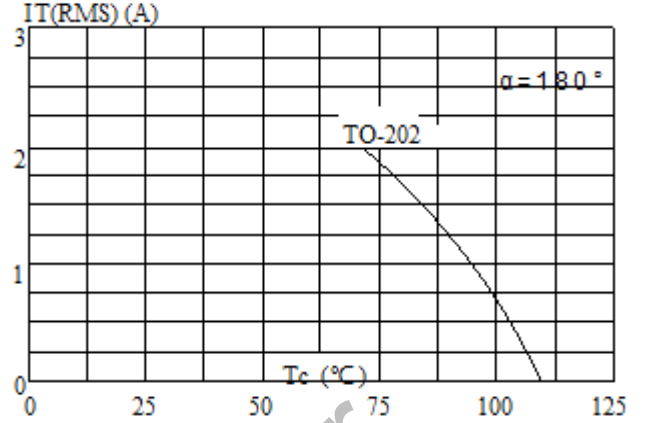


FIG.3: Surge peak on-state current versus number of cycles

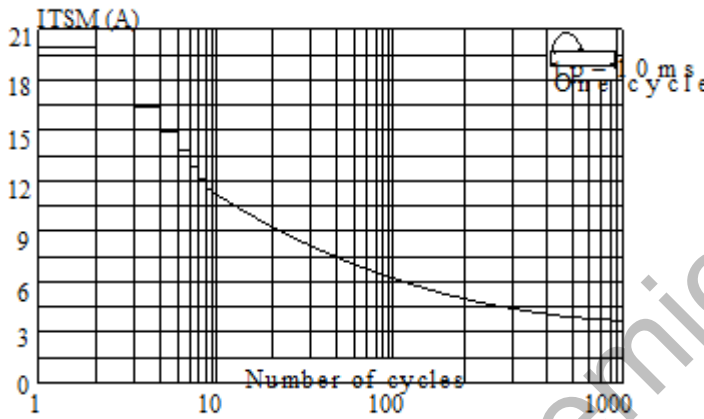


FIG.4: On-state characteristics (maximum values)

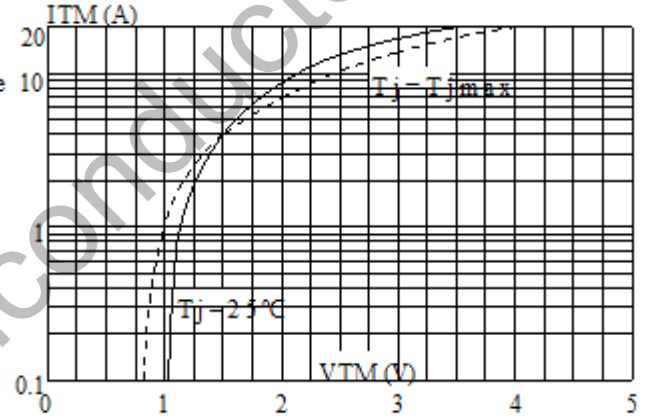


FIG.5: Non-repetitive surge peak on-state current for a sinusoidal pulse with width $t_p < 10\text{ms}$, and corresponding value of $I t$ ($dI/dt < 50\text{A}/\mu\text{s}$)

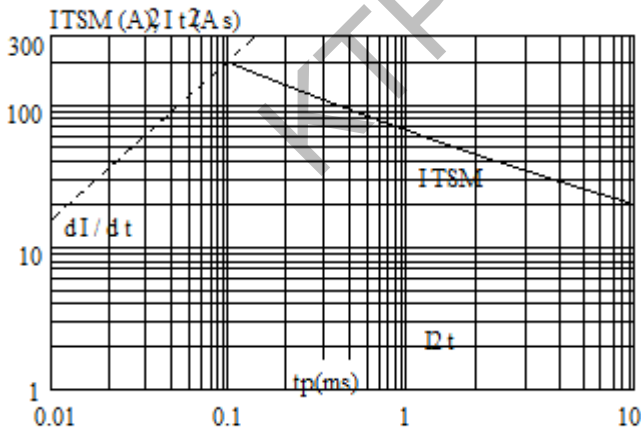


FIG.6: Relative variations of gate trigger current, holding current and latching current versus junction temperature

